

## P80105ASG

### General Description (概述)

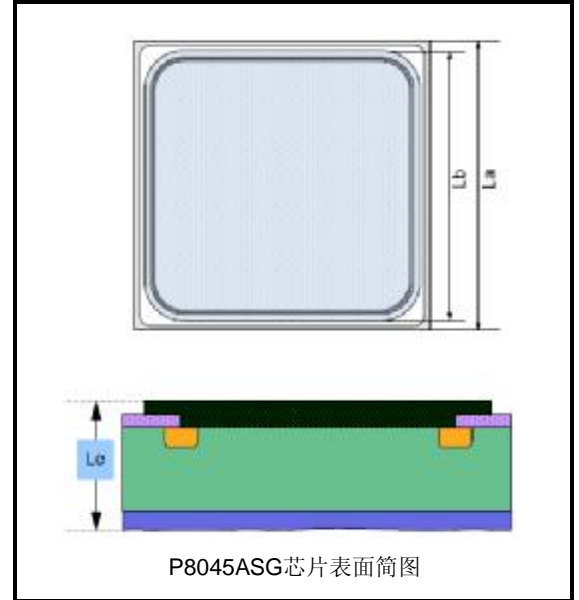
P80105ASG using silicon extension process manufacturing; Low Ir and Extreme Reliability.

P80105ASG是采用硅外延工艺制造的肖特基二极管芯片；低漏电且高可靠性。

All of these Schottky Diodes are designed for applications such as Rectifier, Reverse polarity protection circuit.

该产品广泛用于整流、极性保护电路等。

Items (项目)	Description (描述)
Wafer Size 硅片尺寸	5 Inch
General Parameters 主要参数	105V 10A
Chip Size 管芯尺寸(La)	2040 μm
Pad Size 单颗压点尺寸(Lb)	1930 μm (Typical)
Chip Thickness 芯片厚度(Lc)	280 ± 20 μm
Surface Metal 正面金属	Ag
Backside Metal 背面金属	Ag
Cutting Street 划片道尺寸	50 μm



### Absolute Maximum ratings (极限参数, Ta=25°C)

Parameter 参数	Symbol 符号	Value 额定值	Units 单位
DC Blocking Voltage 最大直流阻断电压	$V_{RRM}$	105	V
Average Rectified Forward Current 正向平均整流电流	$I_{FAV}$	10	A
Nonrepetitive Peak Surge Current@8.3mS 正向峰值浪涌电流	$I_{FSM}$	150	A
Operating Junction Temperature 最高工作结温	$T_J$	150	°C
Storage Temperature 存储温度	$T_{STG}$	-40~150	°C

### Electrical specification (电参数规格, Ta=25°C)

Parameter 参数	Symbol 符号	Test Conditions 测试条件	Min 最小值	Max 最大值	Typ 典型值	Units 单位
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压	$V_{BR}$	$I_R=100\mu A$	105	-	-	V
Forward Voltage 正向压降	$V_F$	$I_F=5A$	-	0.72	0.69	V
		$I_F=10A$	-	0.87	0.84	V
Reverse Leakage Current 反向漏电流	$I_R$	$V_R=105V$	-	50	-	μA

声明:

- 1、扬州国宇保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 2、划片损失及崩边不能超出划片道给定尺寸范围。
- 3、当测试温度变化参数亦会有所调整。